		Зона	Паз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
НӘМПОИ	KITTB:468172.001					
леов, по	B.4681			Конденсаторы		
<u> </u>	KITT		<i>C1-C7</i>	Конденсатор ССО603KRX7R9BB104, ф. Yageo, Тайвань	7	<u>имп. изд.</u>
			<i>C8</i>	Конденсатор СС1206ККХ5R8BB106, ф. Үадео, Тайвань	1	имп. изд.
			C9-C14	Конденсатор ССО603KRX7R7BB105, ф. Yageo, Тайвань	6	имп. изд.
			C15	Конденсатор EEHZC1H1O1P, ф. Panasonic, Япония	1	имп. изд.
o/			<i>C16</i>	Конденсатор ССО603KRX7R9BB102, ф. Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
Chadb. Nº			<i>C17-C19</i>	Конденсатор C1210C475K5RACTU,	3	имп. изд.
W)				ф. Kemet Electronics, США		
			C20	Конденсатор ССО603KRX7R9BB103, ф. Үадео, Тайвань	1	имп. изд.
			C21	Конденсатор 08055D105KAT2A, ф. Куосега AVX, США	1	имп. изд.
			<i>C22</i>	Конденсатор C1210C475K5RACTU,	1	имп. изд.
				ф. Kemet Electronics, США		
D	i		C23	Конденсатор ССО6ОЗКРХ7R9BB472, ф. Үадео, Тайвань	1	имп. изд.
, дата			<i>C24</i>	Конденсатор ССО603KRX7R9BB104, ф. Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
70gu r			C25	Конденсатор 08055D105KAT2A, ф. Куосега AVX, США	1	имп. изд.
			<i>C26</i>	Конденсатор ССО603ZRY5V9BB224, ф. Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
ΠQU			<i>C27</i>	Конденсатор ССО6ОЗКRX 7R9BB333, ф. Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
ИНВ. № дибл.			C28, C29	Конденсатор ССО603KRX7R9BB104, ф. Yageo, Тайвань	2	имп. изд.
Инв			C30, C31	Конденсатор С1210С476М4РАСТИ,	2	имп. изд.
OHD No				ф. Kemet Electronics, США		
HI W						
Н.контр.: 10 Взам						
Н.ко. дата						
7	1					
Подп				PEYH.468172.001	1733	
αδ: 7.	:	Изм. Разр	Лист № д. раб. Подле	77. //	Лист Листов	
Разрад: Nº подл		Про				1 5
WHB. N		- · ·	онтр.	Перечень элементов		
		טוווכ	. <u>ши</u> о//L	NOU		

Копировал: Формат А4

Зона	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
	200			
	<i>C32</i>	Конденсатор ССО6ОЗКRX7R9BB1O4, ф. Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
	C33, C34	Конденсатор EEE-FP1A221AP, ф. Panosonic, Япония	2	имп. изд.
		Микросхемы		
	DA1	Микросхема TLV70233DBVT, ф. Texas Instruments, США	1	имп. изд.
	DA2	Микросхема K7805-500R3, ф. Mornsun Power, Kumaū	1	имп. изд.
	DA3	Микросхема INA 199A 1DCKT, ф. Texas Instruments, США	1	имп. изд.
	DA4	Микросхема LT3741EFE#PBF, ф. Analog Devices, США	1	имп. изд.
	DA5	Микросхема LMV321IDBVT, ф. Texas Instruments, США	1	имп. изд.
	DD1	Микроконтроллер STM32F030C8T6,	1	имп. изд.
		ф. ST Microelectronics, Швейцария		
	DD2	Микросхема MAX232ID, ф. Texas Instruments, США	1	имп. изд.
	DD3	Микросхема SN74LVC1G3157DBVR,	1	имп. изд.
		ф. Texas Instruments, США		
	HL1	Светодиод APT1608CGCK, ф. Kingbright, Тайвань	1	имп. изд.
	HL2	Светодиод APT1608EC, ф. Kingbright, Тайвань	1	имп. изд.
		PEYH.468172.0010	733	Λυ

Подп. и дата

Взам. инв. №

Зона	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
		Ферритовая бусина BLM18TG102TN1D,	1	имп. изд.
	LI	ф. Murata Manufacturing, США	/	<i>arm. aso.</i>
		Катушка индуктивности 7443551130,	1	имп. изд.
	LZ	ф. Wurth Elektronik, Германия	/	ערווו. עסט.
		Ψ. Wui III LIEKII UIIIK, I EPIIUHUN		
\Box		Резисторы		
	D1	D DCOCOSED 0740VI + V T 76	1	7
	R1	Резистор RC0603FR-0710KL, ф. Yageo, Тайвань	/	<i>ИМП. ИЗФ.</i>
	R2	Резистор RCO603FR-071KL, ф. Yageo, Тайвань	1	<i>ИМП. ИЗ</i> Ф.
	R3	Резистор RC0603FR-07100KL, ф. Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
	R4	Резистор RCO603FR-071KL, ф. Yageo, Тайвань	/	<i>ИМП. ИЗД.</i>
	R5	Резистор RC0603FR-07360KL, ф. Yageo, Тайвань	/	<i>ИМП. ИЗД.</i>
	R6	Резистор RC0603FR-07120KL, ф. Yageo, Тайвань	/	<i>ИМП. ИЗД.</i>
	R7	Резистор RC0603FR-0745K3L, ф. Yageo, Тайвань	/	<i>ИМП. ИЗ</i> д.
	R8	Резистор RC0603FR-07680KL, ф. Yageo, Тайвань	/	<i>имп. изд.</i>
_	R9, R10	Резистор RCO603FR-07100KL, ф. Yageo, Тайвань	2	<i>ИМП. ИЗ</i> Д.
	R11	Резистор RT0603DRD0765K5L, ф. Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
	R12	Pesucmop RC0603FR-070RL, ф. Yageo, Тайвань	/	имп. изд.
_	R13, R14	Pesucmop RC0603FR-0710RL, ф. Yageo, Тайвань	2	<i>ИМП. ИЗ</i> д.
	R15, R16	Резистор CRCW2512100KFKEG, ф. Vishay, США	2	<i>ИМП. ИЗД.</i>
	R17	Резистор RCO603FR-0710KL, ф. Yageo, Тайвань	/	<i>ИМП. ИЗД.</i>
	R18	Резистор RC0603FR-079K1L, ф. Yageo, Тайвань	1	<i>ИМП. ИЗ</i> д.
\dashv	R19	Резистор RCO6O3FR-0711KL, ф. Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
	RP1	Потенциометр 3224W-1-103E, ф. Bourns, США	1	имп. изд.
		PEYH.468172.0017	 7 <i>7</i>	ЛU

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Зана	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
	VD1	Диод SMAJ24CA-E3/61, ф. Vishay Semiconductors, США	1	имп. изд.
	VD2	Стабилитрон BZT52C3V3S-7-F,	1	имп. изд.
		ф. Diodes Incorporated, США		
	VD3	Диод РМЕG6010CEH, ф. NXP Semiconductors, Китай	1	имп. изд.
	VD4, VD5	Диод MBRA340T3G, ф. ON Semiconductor, США	2	имп. изд.
	VD6	Диод РМЕG6010CEH, ф. NXP Semiconductors, Китай	1	имп. изд.
	VT1	Транзистор FDD6637, ф. ON Semiconductor, США	1	имп. изд.
H	VT2	Транзистор BSC011N03LSI,	1	имп. изд. имп. изд.
	V / Z	ф. Infineon Technologies Corporation, Германия	,	
	VT3	Транзистор BSC080NO3LSG,	1	имп. изд.
		ф. Infineon Technologies Corporation, Германия		
		Соединители		
	X1	Вилка L-KLS1-207C-2,50-2-10-S,	1	<u>имп. изд.</u>
		ф. KLS Electronic, Kumaū		
	X2, X3	Клемма РСВ7М3, ф. Yuansichuang, Kumaū	2	имп. изд.
	X4	Вилка 87834-0819, ф. Molex, США	1	имп. изд.
	X5, X6	Клемма РСВ7М3, ф. Yuansichuang, Kumaū	2	имп. изд.
	<u> </u>			
Изм	/lucm № до.	РЕУН.468172.001П	193	<i>/\ut</i>

Взам. инв. №

HEAV HEAV PROV. HEAV PROV. HEAV PROV. HEAVER						Лисп	т регистрации изменений				
REPI ARCH ARCH REPI ARCH REPI ARCH REPI ARCH REPI ARCH ARCH REPI ARCH ARCH ARCH ARCH ARCH	Изм	-			1	листов		Входящий номер	Подпис	Дата	
	71311.	HPH-	HPH-		рован-		Horiep oukgrienina	документа и дата	TIOOTIGED	дити	
								/ / 0 / 50 00 : 5-		Лис	
	Изм.	м. Лист № докум. Подп. Дата				Дата				5 A4	